

(43) 国際公開日
2017 年 10 月 5 日(05.10.2017)



(10) 国際公開番号

WO 2017/170021 A1



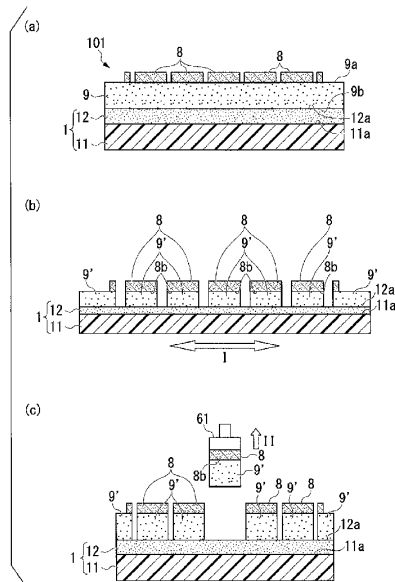
- | | |
|--|---|
| <p>(51) 国際特許分類:
 <i>H01L 21/301</i> (2006.01) <i>C09J 7/02</i> (2006.01)
 <i>B32B 27/00</i> (2006.01) <i>C09J 201/00</i> (2006.01)</p> | <p>(72) 発明者: 鈴木 英明(SUZUKI Hideaki); 〒1730001 東京都板橋区本町2 3番2 3号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 仲秋 なつき(NAKAAKI Natsuki); 〒1730001 東京都板橋区本町2 3番2 3号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 土山 さやか(TSUCHIYAMA Sayaka); 〒1730001 東京都板橋区本町2 3番2 3号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 佐藤 明德(SATO Akinori); 〒1730001 東京都板橋区本町2 3番2 3号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).</p> |
| <p>(21) 国際出願番号: PCT/JP2017/011377</p> | <p>(74) 代理人: 志賀 正武, 外(SHIGA Masatake et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).</p> |
| <p>(22) 国際出願日: 2017年3月22日(22.03.2017)</p> | <p>(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.</p> |
| <p>(25) 国際出願の言語: 日本語</p> | |
| <p>(26) 国際公開の言語: 日本語</p> | |
| <p>(30) 優先権データ:
 特願 2016-069603 2016年3月30日(30.03.2016) JP</p> | |
| <p>(71) 出願人: リンテック株式会社(LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町2 3番2 3号 Tokyo (JP).</p> | |

〔続葉有〕

(54) Title: SEMICONDUCTOR PROCESSING SHEET

(54) 発明の名称：半導体加工用シート

[圖2]



(57) Abstract: A semiconductor processing sheet comprises an adhesive agent layer on a base material, and has the following characteristics: when the adhesive agent layer has a thickness of 200 μm , the adhesive agent layer with the thickness of 200 μm has a storage elastic modulus at 0°C of not more than 1000 MPa, and, when the semiconductor processing sheet is affixed to a mirror surface of a semiconductor wafer, the adhesive agent layer has an adhesive power of not more than 200 mN/25 mm with respect to the mirror surface.

(57) 要約: 基材上に粘着剤層を備え、以下の特性を有する半導体加工用シート: この粘着剤層の厚さを $200\ \mu\text{m}$ としたとき、この厚さ $200\ \mu\text{m}$ の粘着剤層の 0°C における貯蔵弾性率が $1000\ \text{MPa}$ 以下であり、かつ、この半導体加工用シートを半導体ウエハのミラー面に貼付したとき、このミラー面に対するこの粘着剤層の粘着力が $200\ \text{mN}/25\ \text{mm}$ 以下である。

WO 2017/170021 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,

SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))